導電高分子在奈米電極間電荷傳導特性之研究

谷祖賢 許如宏 林鶴南

清華大學材料科學工程系

(NSC 92-2120-E-007-005)

我們結合原子力顯微鏡 (atomic force microscopy, AFM) 的機械微影能力,和一般光學微影技術,製作出具有 奈米級間距的水平電極結構。藉由 AFM 以及掃描式電子顯微鏡 (scanning electron microscopy),定出電極之間 距(L)、寬度(W)、高度(H)分別為 200 nm、13 µm 和 25 nm。並利用此電極量測不同濃度的 MEH-PPV [poly(2-methoxy-5-(2-ethyl-hexoxy)-*p*-phenylene vinylene)]導電高分子的電荷載子傳輸特性,由於僅採用金當作電 極材料,所以我們的研究可以視為是以電洞傳輸為主的電洞單一載子元件。我們將實驗結果以空間電荷限制電 流 (space charge limited current, SCLC) 理論和 Poole-Frenkel 定理來分析,得到無電場下電洞遷移率 (μ_0)分別 為 2.14×10⁻⁴、2.01×10⁻⁵ cm²/Vs,且電場係數 (E₀)為 5.02×10⁵、1.46×10⁵ V/cm。 μ_0 的實驗結果與巨觀尺度相比, 大了約兩個級數,因而可知導電高分子的電荷傳輸特性在奈米尺度時大大地不同。

關鍵字:原子力顯微鏡 (AFM)、奈米間距電極結構、空間電荷限制電流(SCLC)、Poole-Frenkel 定理 MEH-PPV [poly(2-methoxy-5-(2-ethyl hexyloxy)-p-phenylene vinylene)]

1、前言

由於 MEH-PPV 的光電特性,以及具有可適用於 溶液法製成的便捷性,所以讓它成為一種廣泛被使用 與研究的光電高分子。例如:高分子發光二極體 (PLED)、光學雷射和有機積體電路應用等等[1]。然而 有機光電高分子的電荷載子注入,傳輸以及有效的異 性電荷再結合,對於其電致發光特性和效率有著極大 的影響。許多不同的理論模型想要藉由元件的電流-電 壓 (I-V)曲線,定量描述且解釋上述的現象。

較常見的有: Parker 提出以 Fowler-Nordheim 穿 隧理論,來強調以電極注入載子的現象作為主導元件 特性的因素[2];然而 Blom 則認為是以電荷載子於有 機層傳輸的現象,來決定 I-V 的特性[2],並利用空間 電荷限制電流理論[3]作為分析的依據。此外,當是以 傳輸為主導因素時,則電荷載子遷移率會較容易受溫 度和電場的影響,而呈現所謂的 Poole-Frenkel 效應 [4]。

我們的實驗設計,因為是使用金作為電極材料, 由於金本身功函數 (5.1 ev)的因素,所以我們使用的 結構可以視為是歐姆接觸的電洞單一載子元件[5]。因 此本實驗就以研究室溫下不同濃度的 MEH-PPV 光電 高分子,微觀尺度下 I-V 曲線的特性,及探討電洞於 高分子層內部的傳輸現象。

並且更重要的一點,在於我們有別於一般實驗量 測巨觀尺度所使用的三明治結構[3,6],而改用我們自 己利用原子力顯微鏡 (atomic force microscopy, AFM) 的機械力微影技術,搭配簡單的光學微影,製作出的 可調變間距的水平式電極結構,輕易地即可做出奈米 級的間距。

此舉不但大幅減少高分子和電極間的有效接觸面 積,約降低6到7個級數[4,6],進而達到量測微觀、 微量導電高分子性質的目的,雖然未能達到以導電性 原子力顯微鏡 (conducting atomic force microscopy, CAFM) 的奈米尺度量測[7],但已經剔除掉一般以電 子束微影來製作水平式電極結構的繁複與高成本。

2、實驗方法

2.1 電極製作

先將在玻璃基板上以光學微影開出的電極基本圖

樣,用離子濺鍍的方式 (Hitachi E-1010 型),鍍上約 25 nm 厚的金膜,再放入丙酮溶液中,配合超音波震 盪器進行 lift-off。所得圖樣如圖一所示:



圖一:電極基本圖樣,A、B為金膜外接量測線路處 C 為待切割處

接著使用原子力顯微鏡 (NT-MDT-Smena-B 機 台),搭配力學常數為 40 N/m,型號為 NSC15 的探針, 以內部附屬的機械力微影功能,於圖樣中間的橋接處 (C 的地方),切割出不同間距的水平電極結構,示意圖 如圖二所示:



圖二:電極製作圖,箭頭所指為切割方向

但由於 AFM 探針的尖端曲率半徑約為數十 nm, 所以切出小間距容易且均勻,但做出的大間距電極, 則因為探針本身的形狀,和拖曳的狀況而容易產生逐 漸變寬的現象。故本實驗量測上所使用的電極,間距 (L)均為 200 nm。由電極間距的 SEM 圖可知其比較結 果,如圖三所示:



圖三:電極間距的 SEM 圖, (a)200 nm 間距 (b)約 800 nm 間距

然而電極本身的寬度(W)、高度(H)可由圖四的 AFM 表面形貌圖定出。



圖四:圖左為電極的 AFM 表面形貌圖可知寬度(W) 為13 μm,圖右為切線處截面圖可知高度(H)為25 nm,

2.2 MEH-PPV 溶液備製

將 MEH-PPV 粉末分別利用精密天平與定量滴 管,以 3.3mg/ml 以及 1.5mg/l 的濃度比例,溶在氯仿 中,配出濃度差異大的溶液,接著攪拌至完全溶解。

2.3 元件量測

將 MEH-PPV 溶液以滴注法的方式滴在備製的電 極上,以 AFM 輕敲模式的相位訊號,根據材料本身 具有獨特的彈性與黏滯性質,來分辨出不同的物質, 因而得知所滴上的高分子溶液已形成一均勻覆蓋電極 的薄膜,如圖五所示:



圖五:AFM 輕敲模式的相位訊號圖,(a)滴高分子前(b) 滴高分子後,(c)為(a)切線處截面圖,金膜與裸露出的 玻璃相位差約5度,(d)為(b)切線處截面圖,均為滴 上的高分子所以無相位差。 接著以 Keithley 2400 搭配 probe station 作為電壓-電流量測儀器,每次量測均由 0 V 逐漸加大電壓,並 且在固定電壓條件下重複量測,以確定元件電性的重 複性與再現性。

3、結果與討論

實驗所量得的電流-電壓曲線圖,分別如圖六所示:



圖六:電流-電壓曲線圖 (a) 3.3mg/ml (b)1.5mg/l

依照濃度差異使得結果有所不同,可以看出濃度 稀薄者,因為所含的 MEH-PPV 比例相對較稀少,所 以需要較大的驅動電壓,並且所得到的電流值亦較小。

本實驗以無補獲中心的空間電荷限制電流(trap free space charge limited current, TFSCLC)理論來分析 所得到的實驗數據[3,4,6]

$$J = \frac{I}{W \times H} = \frac{9}{8} \varepsilon_0 \varepsilon_\mu \frac{V^2}{L^3} \tag{1}$$

J 表示電流密度, ϵ_0 真空介電率, ϵ_r 介電常數, μ 電洞 遷移率, V 外加電壓, W、H、L 電極尺寸, 如同前所 描述。常數分別帶入後,以 ϵ_r =3 來做計算,即可求出 電洞之遷移率。

由於是以電荷載子傳輸為主導的機制,所以會出 現明顯的 Poole-Frenkel 效應[4,8,9],同時因為我們並 沒有改變溫度,所以可得到一簡化的 Poole-Frenkel 關 係式 [5,8]:

$$\mu = \mu_0 \exp(\sqrt{E/E_0}) \tag{2}$$

μ0 為無電場下電洞遷移率, Ε外加電場, Ε0 電場係數。

用(1)、(2)式計算出 I-V 曲線所對應的電洞遷移率 與電場的相依性,並利用(2)式將遷移率取自然對數對 電場的平方根作圖,來探討電洞遷移率和電場間的關 係,結果如圖七所示:



圖七:遷移率取自然對數對電場的平方根做圖 (a)3.3mg/ml (b)1.5mg/l

由圖七的截距與斜率,分別對應出(2)式所表示的 μ₀、 E₀,數值整理如表一:

	$\mu_0(cm^2/Vs)$	$E_0(V/cm)$
3.3mg/ml	2.14×10 ⁻⁴	5.02×10 ⁵
1.5mg/l	2.01×10 ⁻⁵	1.46×10 ⁵

表一:兩樣品的 μ_0 、 E_0 值

由不同濃度的 MEH-PPV 溶液所造成的結果,僅 使得高濃度樣品的無電場下電洞遷移率 (μ₀)較低濃 度者高出一個級數,但兩結果相較於巨觀尺度下的數 值,均大了約兩個級數[3~6,8]。不過卻接近先前奈米 尺度下量測的結果[7,10]。

其原因為:當逐漸縮小高分子量測的有效體積時,同時也減少了高分子膜內部的不均勻性,使得電 荷載子所需躍遷位置的能量偏差也隨之減小,有利電 荷傳導,進而獲得遷移率的大幅增加[7,11]。

但就電場係數 (E₀) 而言,本實驗結果和巨觀或是 奈米尺度的量測結果並無明顯的不同[3~8,10],因此又 再一次的證明: E₀ 是一個受材料和溫度影響而變化的 參數[9]。

4、結論

我們結合 AFM 與光學微影技術,取代了電子束微 影,輕易地製作出奈米間距的水平電極結構。並應用 此電極,研究微觀尺度下 MEH-PPV 光電高分子的電 荷載子傳輸現象,得到符合 TFSCLC 理論,以及 Poole-Frenkel 定律的結果。不但證明了電極結構的可 行性,同時也探討出有機材料在微觀、微量下的導電 特性。

誌謝

感謝國科會工程處材料學門經費補助(NSC 92-2120-E-007-005)以及清華大學化工所陳明志先生 及陳壽安教授所提供高分子材料。

參考文獻

- H. Sirringhaus, N. Tessler, and R. H. Friend, Science 280, 1741 (1998)
- [2] Y. Kawabe, G. E. Jabbour, and S. E. Shaheen, Appl. Phys. Lett. 71, 1290 (1997).
- [3] P. W. M. Blom, M. J. M. de Jong, and J. J. M. Vleggaar, Appl. Phys. Lett. 68, 3308 (1996).
- [4] P. W. M. Blom, M. J. M. de Jong, and M. G. van Munster, Phys. Rev. B 55, 656 (1997).
- [5] L. Bozano, and S. A. Carter, Appl. Phys. Lett. 74, 1132 (1999).
- [6] A. J. Campell, D. D. C. Bradley, and D. G. Lidzey, J. Appl. Phys. 82, 6326 (1997).
- [7] H.-N. Lin, H.-L. Lin, S.-S. Wang, Liang-Sheng Yu, Gung-Yeong Perng, and Show-An Chen, and S. H. Chen, Appl. Phys. Lett. 81, 2572 (2002).
- [8] J. M. Lupton, and I. D. W.Samuel, J. Phys. D: Appl. Phys. 32, 2973 (1999).
- [9] S. V. Rakhmanova, and E. M. Conwell, Synthetic Metals 116, 389 (2001).
- [10] J. H. Park, H. Y. Yu, and J. G. Park, Thin Solid Films 393, 129 (2001)
- [11] S. V. Rakhmanova, and E. M. Conwell, Appl. Phys. Lett. 76, 3822 (2000).